

	<h2>SI6562CDQ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI6562CDQ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 6.7A 8-TSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI6562CDQ-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2598 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



### Spezifikationen

Teilenummer	SI6562CDQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6.7A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2598 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 5.7A, 4.5V
Leistung - max	1.6W, 1.7W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6562CDQ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 6.7A, 6.1A 1.6W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A, 6.1A
Basisteilenummer	SI6562

SI6562CDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6562CDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6562CDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6562CDQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6562DQ</b> VISHAY VISHAY TSSOP-8</p>	 <p><b>SI6552DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6552DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI6562DQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6562DQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP</p>
 <p><b>SI6562CD</b> VISHAY SI6562CD VISHAY</p>	 <p><b>SI6562CDQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.7A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6562CDQ-T1-E3</b> VISHAY VISHAY TSSOP-8</p>	 <p><b>SI6562DQ-T1</b> VISHAY SI6562DQ-T1 VISHAY</p>

### SI6562CDQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI6562CDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6562CDQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6562CDQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6562CDQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6562CDQ-T1-GE3
SI6562CDQ-T1-GE3 Electronic	SI6562CDQ-T1-GE3-Komponenten	SI6562CDQ-T1-GE3-Verteiler	SI6562CDQ-T1-GE3-Bild	SI6562CDQ-T1-GE3-Teil
SI6562CDQ-T1-GE3 Preis	SI6562CDQ-T1-GE3 Hersteller	SI6562CDQ-T1-GE3 Bild	SI6562CDQ-T1-GE3 Aktie	SI6562CDQ-T1-GE3 Inventar
SI6562CDQ-T1-GE3 Neu	SI6562CDQ-T1-GE3 Original	SI6562CDQ-T1-GE3 garantiert	SI6562CDQ-T1-GE3 RFQ	SI6562CDQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited